

PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6

C03B 8/04, 20/00, 37/014

A1

(11) 国際公開番号

WO00/12438

(43) 国際公開日

2000年3月9日(09.03.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/04609

JP

JP

(22) 国際出願日

1999年8月26日(26.08.99)

(30) 優先権データ

特願平10/244809 特願平11/002968 1998年8月31日(31.08.98)

1999年1月8日(08.01.99)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

住友電気工業株式会社

(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP] 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

石原朋浩(ISHIHARA, Tomohiro)[JP/JP]

齋藤達彦(SAITOH, Tatsuhiko)[JP/JP]

大賀裕一(OHGA, Yuichi)[JP/JP]

〒244-8588 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地

住友電気工業株式会社 横浜製作所内 Kanagawa, (JP)

(74) 代理人

弁理士 上代哲司, 外(JODAI, Tetsuji et al.)

〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目1番3号

住友電気工業株式会社内 Osaka, (JP)

(81) 指定国

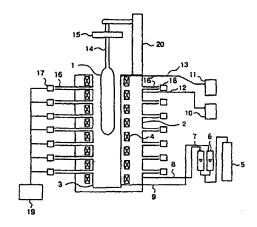
AU, CN, GB, JP, KR, US

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: METHOD OF PRODUCING GLASS ARTICLE AND GLASS BASE MATERIAL FOR OPTICAL FIBER

(54)発明の名称 ガラス物品の製造方法及び光ファイバ用ガラス母材



(57) Abstract

A high-quality, large glass article and a method of producing it; specifically, a long (1000 mm or longer) glass base material for optical fiber which is small in lengthwise variation and a method of producing it, the method comprising the first heating step of inserting a glass fine grain deposit synthesized by vapor phase synthesizing method into a heating furnace perpendicularly, heating the deposit at temperatures lower than a transparentizing temperature in a vacuum or depressurized atmosphere, removing gas remaining in the glass fine grain deposit and shrinking the deposit by heating, and the second heating step of heating the deposit at a transparentizing temperature to transparentize the glass fine grain deposit, characterized in that the second heating step controls heating for a preset time of not shorter than 70 min so that a glass fine grain deposit surface temperature is 1400 to 1480 °C and is followed by a cooling step for cooling the glass article.

本発明は、高品質な大型ガラス物品及びその製造方法に関するもので、特に、長尺かつ外径の 長手方向変動 の小さい光ファイバ用ガラス母材及びその製法に関し、気相合成法により合成したガラス微粒子堆積体を加熱炉に鉛直方向に挿入し、真空又は減圧雰囲気中で透明化温度より低い温度で加熱して、前記ガラス微粒子体に残留するガスを除去するとともに加熱収縮させる第1の加熱工程と、透明化温度で加熱して前記ガラス微粒子体を透明化させる第2の加熱工程とを有し、前記第2の加熱工程がガラス微粒子堆積体表面の温度が1400~1480℃となるように制御して70分以上の所定の時間加熱し、第2の加熱工程の後にガラス物品を冷却する冷却工程を有することを特徴とする長さが1000mm以上のガラス物品の製造方法及び該方法で得られるガラス物品である。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

RO

韓国

RSSESSIKLNZDDG」ススシンススシンセステトダットトトウウ米ウヴュ南ジーズスシンススシセスチトダットトトウウ米ウヴュ南ジーススシンススシン・コキザシーボメーズ・ボーニキレン タア・メーボニテ・ルラドースニメ ダイダ キトーリブン・カーススシン・スチトダット・トウウ米ウヴュ南ジーズスクシススシセスチトダット・トウウ米ウヴュ南ジーズスカスススンススタースの大学 マイグ キトーリブアイ アングログロ アングログロ アングログ アングログログ アングログ ア

明細書

ガラス物品の製造方法及び光ファイバ用ガラス母材

技術分野 5

本発明は高品質な大型のガラス物品及びその製造方法に関する。特に、 長尺かつ外径のばらつきの小さい光ファイバ用ガラス母材及びその製法に 関する。

10 背景技術

25

フォトマスク用ガラス母材、光ファイバ用ガラス母材等のガラス物品は、 気相軸付法(VAD法)あるいは外付法(OVD法)等の気相合成法により 合成されたガラス微粒子堆積体を、加熱炉中で真空あるいは減圧雰囲気下で 髙温加熱処理し、透明化して製造される。高品質のガラス物品を得るために 15 は、ガラス母材中への気泡の残留を極力無くし、かつ、その母材の外径を均 一とすることが必要である。そのための方法として、加熱透明化工程を3エ 程に分け、それぞれの工程の温度を適切に制御する方法が提案されている (特開平6-256035号公報)。この方法は、加熱処理中にガラス微粒 子堆積体に残留するガスを除去する第1の加熱工程、前記第1の加熱工程の 加熱温度より高く、前記堆積体の透明化温度より低い温度で加熱収縮させる 20 第2の加熱工程、及び前記透明化温度で前記堆積体を透明化させる第3の加 熱工程を含むことを特徴としている。また、この方法の第2の加熱工程にお いて、ガラス微粒子堆積体を加熱する発熱体を上下方向に多段に分割しそれ ぞれ独立に温度を制御できるようにしている。下部の発熱体の温度が上部の 発熱体の温度以上になるように設定することにより、ガラス物品の長手方向 の外径変動を小さくする効果がある。

近年、大量生産の必要性や製造工程の効率化の観点から、大型のガラス微 粒子堆積体を使用して、長さが1000mm以上かつ品質のすぐれた(気泡

10

15

20

の残留がなく、外径の長手方向の変動が小さい) 光ファイバ母材の製造方法 の確立が望まれている。

本発明者らは、自重の影響が大きくなる長さ1000mm以上の光ファイバ用ガラス母材では、前記第3の加熱工程のような高温(1490~1600°)での加熱処理を行うと、外径の長手方向の変動が大きいという問題に気づいた。

また、本発明者らは、透明化温度が1490℃より低い温度の場合は、加熱時間が1時間以下であると、前記堆積体の透明化が難しく、前記堆積体の両端部に焼きのこし(完全に透明化されていない部分)ができるという問題に気づいた。

発明の開示

本発明は、大型のガラス微粒子堆積体から長手方向に外径が安定した大型の高品質のガラス物品を得ることができる製造方法を提供することを目的とする。

第1の発明は、気相合成法により合成したガラス微粒子堆積体を加熱炉に 鉛直方向に挿入し、真空又は減圧雰囲気中で透明化温度より低い温度で加熱 して、前記ガラス微粒子体に残留するガスを除去するとともに加熱収縮させ る第1の加熱工程と、透明化温度で加熱して前記ガラス微粒子体を透明化さ せる第2の加熱工程とを有し、前記第2の加熱工程がガラス微粒子堆積体表 面の温度が1400~1480℃となるように制御して70分以上の所定 の時間加熱し、第2の加熱工程の後にガラス物品を冷却する冷却工程を有す る長さが1000mm以上のガラス物品の製造方法に関する。

第2の発明は、前記第1の加熱工程が1000~1300℃で10Pa以 25 下の所定の真空度になるまで前記ガスの除去を行う脱気工程を有する第1 の発明のガラス物品の製造方法に関する。

第3の発明は、前記第1の加熱工程が1000~1300℃で10Pa以下の所定の真空度になるまでガスの除去を行う脱気工程と、10Pa以下の

所定の真空度において1300~1400℃で加熱する加熱収縮処理工程 とからなる第1の発明のガラス物品の製造方法に関する。

第4の発明は、前記加熱炉は、長手方向の複数部分に対応してそれぞれ独立に制御されたヒータを備え、前記ガラス微粒子堆積体の温度を長手方向の複数部分に分けて制御する第1の発明のガラス物品の製造方法に関する。

第5の発明は、前記各加熱工程において、前記ヒータと前記ガラス微粒子 堆積体とを隔離する炉心管の温度を測定し、その温度に基づいて各加熱工程 の温度を制御する第1の発明のガラス物品の製造方法に関する。

第6の発明は、前記ガラス微粒子堆積体は透明ガラスロッドとその周囲に 10 形成された多孔質ガラス部分からなる複合母材である第1の発明のガラス 物品の製造方法に関する。

第7の発明は、前記第2の加熱工程において、前記ガラス微粒子堆積体表面の温度を上方から下方へ向かって連続的又は段階的に高くする第1の発明のガラス物品の製造方法に関する。

15 第8の発明は、透明ガラスロッドとその周囲に形成された多孔質ガラス部分からなり、所定の外径を有する複合母材であるガラス微粒子堆積体を透明化温度で加熱して、前記多孔質ガラス部分を透明化させて、透明化後のガラス母材の外径の長手方向の変動が該外径の長手方向の中央値に対して±2%以内となるように形成され、長さが1000mm以上である光ファイバ20 用ガラス母材に関する。

本発明の方法によれば、大型のガラス微粒子堆積体から、長さが1000 mm以上であり、外径の長手方向の変動が外径の長手方向の中央値に対して ±2%以内という光ファイバ母材を容易に製造することができる。

25 図面の簡単な説明

図1は、実施例で使用した真空焼結炉の装置構成を示す概略説明図である。 図2は、実施例1及び比較例1で得られた光ファイバ母材の長手方向にお ける外径変化を示す図である。

図3は、実施例3における温度制御の状態を示す模式図。

発明の実施するための最良の形態

10 前記第1の加熱工程後のガラス微粒子堆積体は、第2の加熱工程において、1400~1480℃の温度範囲で70分以上加熱し、透明化される。加熱温度は、1400~1480℃と従来の透明化温度よりも低く設定することにより、自重による前記堆積体の引き延びが低減される。この場合、加熱温度が下がりやすい該堆積体の両端部においては、完全に透明化されない部分が発生することがあるが、加熱時間を70分以上の所定の時間に設定することにより該堆積体の両端部を完全に透明化することができる。このように透明化温度を低くすることにより、長さが1000mmの大型の光ファイバ用ガラス母材では、母材外径の長手方向の変動が外径の長手方向の中央値に対し±2%以内にすることができる。

20 本発明に使用される加熱炉は、ガラス微粒子堆積体の温度を長手方向の複数部分に分けて制御するため、長手方向の複数部分に対応してそれぞれ独立に制御できる複数のヒータを備えることが好ましい。このようにすることによって、長尺のガラス微粒子堆積体を加熱する場合でも引き延びやすい部分と引き延びにくい部分の温度を適切に制御することができる。

25 ガラス微粒子堆積体を鉛直方向に挿入するたて型の加熱炉を使用する場合、高温での加熱処理の際に自重による引き延びが発生して外径が上部では細く、下部では太くなる傾向がある。そのような場合には、第2の加熱工程においてガラス微粒子堆積体表面の温度が上端から下方へ向かって連続的

又は段階的に高くなるように制御するのが好ましい。

ガラス微粒子堆積体の透明化では、該堆積体を加熱炉のヒータから隔離するため、該堆積体はヒーターとの間にカーボン材等からなる炉心管を介して挿入される。

5 前記第1及び第2の加熱工程における温度制御は、放射温度計等の温度センサを使用してガラス微粒子堆積体表面の温度を測定し、その測定値に基づいてヒータの出力を制御することによって行うようにする。該堆積体表面の温度は炉心管の温度に近い温度となっていることが多く、その場合、より測定が容易な炉心管の温度を測定し、その測定値に基づいてヒータの出力を制10 御するようにしてもよい。

実施例

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明する。

(実施例1a)

VAD法で合成した純シリカからなるガラス微粒子堆積体を図1に示す 15 真空焼結炉を使用して本発明の方法に従い透明ガラス化した。図1の真空焼 結炉において1はガラス微粒子堆積体、2は真空焼結炉本体、3は炉心管、 4はヒータ、5は不活性ガス供給装置、6及び7はそれぞれ炉心管3及び炉 本体2内へ供給する不活性ガスの流量計、8及び9はそれぞれ炉心管3及び 炉本体2への不活性ガスの供給用配管、10及び11は炉内減圧用吸入ポン 20 プ、12及び13はそれぞれ炉本体2及び炉心管3から排気するための配管、 14は母材1を支えるシード棒、15は上蓋、16は母材1の表面温度計測 用の炉心管3まで貫通しているのぞき穴、16′は炉心管3の温度計測用の ぞき穴、17は母材1の表面温度を計測する温度計、18は炉心管3の温度 25 を計測する温度計、19は温度制御装置、20はトラバース機である。なお、 図では炉本体2及び炉心管3の両方にそれぞれ別々にガス供給、排気手段を 設けているが、これらはどちらか一方のみとすることもできる。 また、 図に は記載を省略したが配管8、9、12、13にはバルブが設けられており、

これらのバルブの切替えで真空(減圧)排気又はガスの吹流しを行う。さらに、これも図示省略したが、温度計18は温度制御装置19にも接続されている。ガラス微粒子堆積体1は、VAD法で形成され、外径200mm、重量30kg、有効部長さ1500mmのものを使用した。真空焼結炉の温度を400℃に保って該堆積体1を炉心管3に挿入し、上蓋15で炉内を密封し、炉内圧力を10Paまで下げた。この状態で該堆積体1の全域における表面温度を10℃/分の昇温速度で1300℃まで上昇させて60分間保持し、該堆積体1に残留したガスを十分に脱気した(脱気工程)。

次に該堆積体1の表面温度を5℃/分で上昇させ、1350℃で50分間 10 保持した(加熱収縮処理工程)。

次に該堆積体 1 の表面温度を 5 $\mathbb{C}/分$ で上昇させ、該堆積体 1 の全域における表面温度を 1 4 2 0 \mathbb{C} とした後、 1 0 0 分間保持して透明化した(透明化工程)。

この後、ヒータでの加熱を停止して降温を続け、ガラス物品を冷却し(冷 15 却工程)、600℃で製品を取り出した。

得られたガラス物品の寸法を測定した結果、有効部長さ1400mm全長にわたって外径は90±0.5mm(外径変化率±0.56%)であり、外径の長手方向の変動が小さく、良好な品質を有していた。

(実施例1b)

20 また、実施例1 a のガラス微粒子堆積体1に代えて、中心部にG e がドープされ屈折率を高くし、外周部に純SiO,層を有する透明ガラスロッドの周囲に、VAD法によりSiO,の多孔質ガラス層を形成した実施例1 a と同寸法の複合母材を用いて、実施例1 a と同様に透明化したが、同様に良好な品質が得られた。

25 (実施例1c)

また、ガラス微粒子堆積体1として、外径300mm、有効部長さ1500mm、重量60kgのものを使用し、実施例1aと同様に脱気工程、加熱処理工程を行った後、該堆積体1の表面温度を5℃/分で上昇させ、該堆積体

1 の全域における表面温度を 1 4 2 0 ℃とした後、1 8 0 分間保持して透明化した。

得られたガラス物品の寸法を測定した結果、有効部長さ1400mm全長にわたって外径は 150 ± 1.2 mm(外径変化率 $\pm0.6%$)と良好な品質が得られた。

(比較例 1 a)

5

10

25

実施例1 a と同サイズのガラス微粒子堆積体1を、同じ設備により以下の条件で透明ガラス化した。すなわち、真空焼結炉の温度を400℃に保って該堆積体1を炉心管3に挿入し、上蓋15で炉内を密封し、炉内圧力を10 P a まで下げた。この状態で該堆積体1 の全域における表面温度を10 ℃/分の昇温速度で1300℃まで上昇させて60分間保持し、該堆積体1に残留したガスを十分に脱気した(脱気工程)。

次に、該堆積体 1 の表面温度を 5 \mathbb{C}/\mathcal{O} で上昇させ 1 3 5 0 \mathbb{C} とし、同温度で 5 0 \mathcal{O} 份間保持した(加熱収縮処理工程)。

次に、該堆積体1の表面温度を5℃/分で上昇させ、該堆積体1の全域における表面温度を1500℃とした後、60分間保持して透明化した(透明化工程)。この後、ヒータでの加熱を停止して降温を続け、600℃で製品を取り出した。得られたガラス物品の寸法を測定した結果、有効部長さ1400mm全長にわたって外径は90±4.5mm(外径変化率±5%)であり、外径の長手方向の変動が大きかった。

(比較例 1 b)

実施例1cと同サイズのガラス微粒子堆積体1を使用し、比較例1aと同じ条件で透明化した。得られたガラス物品の寸法を測定した結果、有効部長さ1550mm全長にわたって外径は150±5.0mm(外径変化率±3.3%)であり、外径の長手方向の変動が大きかった。

実施例1 a 及び比較例1 a の結果は、表1 のとおりである。また、これらの例における長手方向に対する外径変動の傾向を図2に示す。第2 の加熱工程(透明化工程)において、従来技術よりも低い1400~1480℃の範

囲(好ましくは1400~1440℃の範囲)で70分以上(好ましくは100分以上、さらに好ましくは150分以上)保持して引き延びを防止することが、外径の安定化に重要であることがわかる。

実施例において、炉内の真空度を10Paとしているが、ガラス物品中の 5 気泡の残留を防ぐため、この値は低い方が好ましく、9Pa、8Paであっ ても良い。

本発明の方法は、ガラス物品の自重が大きい場合、特に、自重が50kg以上のものほど外径変動の低減に有効である。

10 表 1 処理条件及び得られたガラス物品の外径変動

		実施例 1 a		比較例la	
ATT 1 TO	1	温度 (℃)	時間 (分)	温度 (℃)	時間 (分)
第1の 加熱	脱気工程	1 3 0 0	6 0	1 3 0 0	6 0
工程	加熱収縮処理工程	1 3 5 0	5 0	1 3 5 0	5 0
第2の加熱工程		1 4 2 0	100	1500	6 0
外径変動 (mm)		± 0.	5	± 4 .	5

(実施例2a)

実施例1 a と同サイズのガラス微粒子堆積体1を、実施例1 a と同じ設備、同じ温度条件で透明化した。ただし、本実施例においては透明化処理中の温度の制御を炉心管3の外表面温度を測定する温度計18を用いて、炉心管3の温度を制御することによって行った。得られたガラス物品の寸法を測定した結果、有効部長さ1400mm全長にわたって外径は90±0.7mm(外径変化率±0.78%)であり、外径の長手方向の変動が小さく、良好な品質を有していた。この結果から、該堆積体1の表面の温度を測定する代わりに、比較的測定の容易な炉心管の温度を測定しても問題のないことがわかる。(実施例2b)

実施例1cと同サイズのガラス微粒子堆積体1を使用し、実施例1cと同じ

条件で透明化した。得られたガラス物品の寸法を測定した結果、有効部長さ 1410mm全長にわたって外径は150±1.5mm(外径変化率±1.0%)と良好な品質が得られた。

(実施例3a)

20

5 実施例1aと同サイズのガラス微粒子堆積体1を、図1の真空焼結炉と同 形式で、ヒータ4を図3に示すように上段ヒータ4-1、中段ヒータ4-2 及び下段ヒータ4-3の3段に分割して制御した真空焼結炉を使用して、実 施例1aと同様に透明化した。

該堆積体1は外径200mm、有効部長さ1560mmのものを使用した。 10 真空焼結炉の温度を400℃に保って該堆積体1を炉心管3に挿入し、上蓋 15で炉内を密封し、炉内圧力を10Paまで下げた。この状態で該堆積体 1の全域における表面温度を10℃/分の昇温速度で1300℃まで上昇 させて60分間保持し、該堆積体1に残留したガスを十分に脱気した(脱気 工程)。

15 次に該堆積体1の表面温度を10℃/分で上昇させ、1350℃にして50分間保持した(加熱収縮処理工程)。

次に上段ヒータ4-1の影響を強く受ける該堆積体1の範囲Aの中心点における表面温度を5 $\mathbb{C}/$ 分で上昇させて1400 \mathbb{C} に、中段ヒータ4-2の影響を強く受ける範囲Bの中心点における表面温度を7 $\mathbb{C}/$ 分で上昇させて1420 \mathbb{C} に、下段ヒータ4-3の影響を強く受ける範囲Cの中心点における表面温度を9 $\mathbb{C}/$ 分で上昇させて1440 \mathbb{C} にした後、100分間保持して該堆積体1を透明化させた(透明化工程)。このときの温度分布はほぼ図3に示すとおりである。

この後、ヒータでの加熱を停止して降温を続け、ガラス物品を冷却し(冷 25 却工程)、600℃で製品を取り出した。

得られたガラス物品の外径を測定した結果、有効部長さ1405mm全長にわたって外径は 90 ± 0.1 mm(外径変化率 $\pm0.11%$)であり、外径の長手方向の変動が小さく、良好な品質を有していた。

(実施例3b)

実施例3 a において、該堆積体1の表面温度の制御を、各ヒーター位置に対応する炉心管3の表面温度を測定し制御することによっても、実施例3 a と同様の良好な品質が得られた(有効部長さ1417mm全長にわたって外径は90±0.3mm(外径変化率±0.33%))。

(実施例3c)

5

10

実施例3aのガラス微粒子堆積体1に代えて、中心部にGeがドープされ、外周部に純SiO。層を有する透明ガラスロッドの周囲にVAD法により純SiO。多孔質ガラス層を形成した実施例3aと同寸法の複合母材を用いて、実施例3aと同様に透明化したが、同様に良好な品質が得られた。

(実施例3d)

実施例3aにおいて、1350℃での加熱収縮処理を行っているが、なく ても同様に良好な品質が得られた。

(実施例3e)

- 15 実施例3 a において、実施例3 a のガラス微粒子堆積体1 に代えて、実施例 1 c と同サイズのガラス微粒子堆積体1を使用し、透明化工程で保持時間を 1 8 0 分間とした場合は、有効部長さ1390mm全長にわたって外径は1 50±0.7mm(外径変化率±0.46%)同様に良好な品質が得られた。 (実施例3f)
- 20 実施例3 e において、該堆積体1の表面温度の制御を、各ヒーター位置に 対応する炉心管3の表面温度を測定し制御することによっても、実施例3 a と同様の良好な品質が得られた(有効部長さ1400mm全長にわたって外 径は150±1.0mm(外径変化率±0.66%))。

(実施例3g)

25 外径が365mm、有効部長さ1560mm、重量80kgのガラス微粒 子堆積体1を、実施例3eと同じ設備、同じ条件で透明化した。得られたガラス物品の寸法を測定した結果、有効部長さ1470mm全長にわたり外径は163±1.5mm(外径変化率±0.92%)であった。

(比較例2)

実施例3gと同サイズのガラス微粒子堆積体1を、実施例3eと同じ設備により以下の条件で透明ガラス化した。すなわち、真空焼結炉の温度を400℃に保って該堆積体1を炉心管3に挿入し、上蓋15で炉内を密封し、炉内圧力を10Paまで下げた。この状態で該堆積体1の全域における表面温度を10℃/分の昇温速度で1300℃まで上昇させて60分間保持し、該堆積体1に残留したガスを十分に脱気した(脱気工程)。

次に、該堆積体1の表面温度を5℃/分で上昇させ1350℃とし、同温度で50分間保持した(加熱収縮処理工程)。

次に該堆積体1の表面温度を15℃/分で上昇させ、該堆積体1の全域における表面温度を1500℃とした後、60分間保持して透明化した(透明化工程)。この後、ヒータでの加熱を停止して降温を続け、600℃で製品を取り出した。得られたガラス物品の寸法を測定した結果、有効部長さ1660mm全長にわたって外径は158±7mm(外径変化率±4.43%)であり、外径の長手方向の変動が大きかった。

10

20

12

請求の範囲

- 1. 気相合成法により合成したガラス微粒子堆積体を加熱炉に鉛直方向に挿入し、真空又は減圧雰囲気中で透明化温度より低い温度で加熱して、前記ガラス微粒子体に残留するガスを除去するとともに加熱収縮させる第1の加熱工程と、透明化温度で加熱して前記ガラス微粒子体を透明化させる第2の加熱工程とを有し、前記第2の加熱工程がガラス微粒子堆積体表面の温度が1400~1480℃となるように制御して70分以上の所定の時間加熱し、第2の加熱工程の後にガラス物品を冷却する冷却工程を有することを特徴とする長さが1000mm以上のガラス物品の製造方法。
- 2. 前記第1の加熱工程が1000~1300℃で10Pa以下の所定の 真空度になるまで前記ガスの除去を行う脱気工程を有することを特徴とす る請求の範囲第1項に記載のガラス物品の製造方法。
- 3. 前記第1の加熱工程が1000~1300℃で10Pa以下の所定の 15 真空度になるまでガスの除去を行う脱気工程と、10Pa以下の所定の真空 度において1300~1400℃で加熱する加熱収縮処理工程とからなる ことを特徴とする請求の範囲第1項に記載のガラス物品の製造方法。
 - 4. 前記加熱炉は、長手方向の複数部分に対応してそれぞれ独立に制御されたヒータを備え、前記ガラス微粒子堆積体の温度を長手方向の複数部分に分けて制御することを特徴とする請求の範囲第1項に記載のガラス物品の製造方法。
 - 5. 前記ヒータと前記ガラス微粒子堆積体とを隔離する炉心管の温度を測定し、その温度に基づいて各加熱工程の温度を制御することを特徴とする請求の範囲第1項に記載のガラス物品の製造方法。
- 25 6.前記ガラス微粒子堆積体は透明ガラスロッドとその周囲に形成された多 孔質ガラス部分からなる複合母材であることを特徴とする請求の範囲第1 項に記載のガラス物品の製造方法。
 - 7. 前記第2の加熱工程において、前記ガラス微粒子堆積体表面の温度を

上方から下方へ向かって連続的又は段階的に高くすることを特徴とする請求の範囲第1項に記載のガラス物品の製造方法。

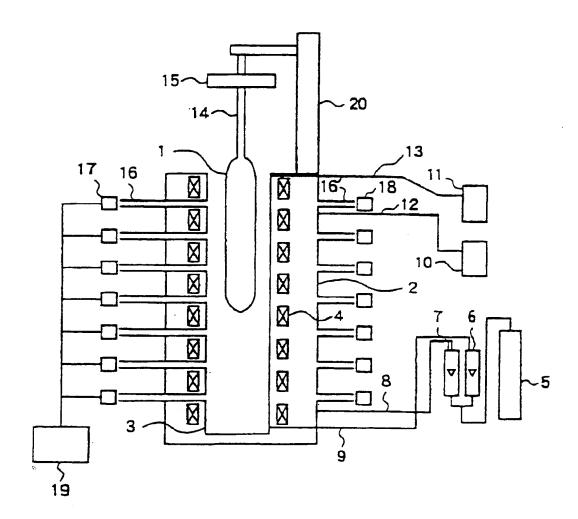
8. 透明ガラスロッドとその周囲に形成された多孔質ガラス部分からなり、 所定の外径を有する複合母材であるガラス微粒子堆積体を透明化温度で加 熱して、前記多孔質ガラス部分を透明化させて、透明化後のガラス母材の外 径の長手方向の変動が該外径の長手方向の中央値に対して±2%以内とな るように形成され、長さが1000mm以上であることを特徴とする光ファ イバ用ガラス母材。

		•	
		•	

WO 00/12438 PCT/JP99/04609

1/3

2 1

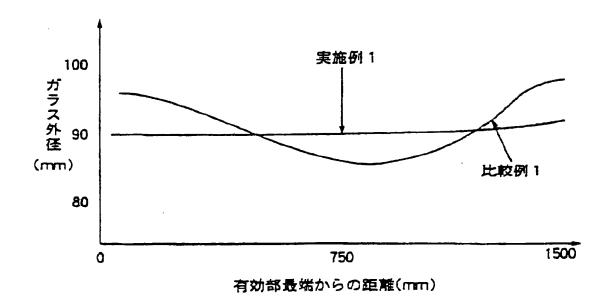


		47
		•
		1.0
		·

PCT/JP99/04609

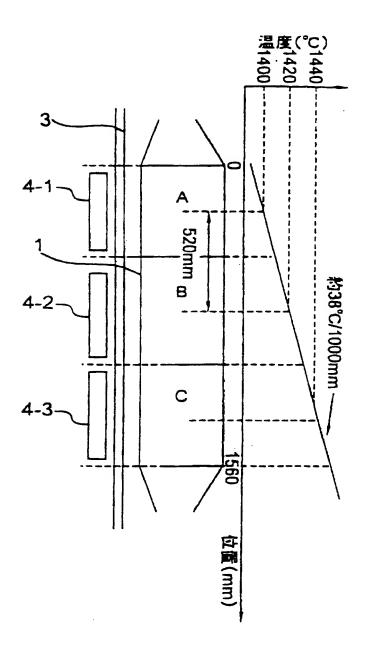
2/3

図 2



- 2	
	L
	~
	~
	•

図 3



		U
		•
		v.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04609

	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ C03B8/04, C03B20/00, C03B37/014					
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	SEARCHED					
Int.		0/00, C03B37/014				
Jits Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999					
	ata base consulted during the international search (name TN), REGISTRY (STN), WPI (STN)	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	JP, 07-081962, A (Sumitomo Elec 28 March, 1995 (28.03.95), Claims (Family: none)	tric Industries, Ltd.),	1-8			
A	JP, 06-256035, A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 1-8 13 September, 1994 (13.09.94), Claims & US, 5693115, A					
A	JP, 05-024854, A (Sumitomo Elec 02 February, 1993 (02.02.93), Claims & US, 5330548, A	tric Industries, Ltd.),	1-8			
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed inventive and occument of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventi						
06 December, 1999 (06.12.99) 14 December, 1999 (14.12.99)						
Name and n	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer					
Facsimile N	io.	Telephone No.				



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 6 C03B8/04, C03B20/00, C03B37/014

B.__調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 6 C03B8/04, C03B19/14, C03B20/00, C03B37/014

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-1999年

日本国登録実用新案公報

1994-1999年

日本国実用新案登録公報

1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), REGISTRY (STN), WPI (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Α	JP, 07-081962, A, (住友電気工業株式会社) 28.3月.1995 (28.03.95) 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-8
Α	JP, 06-256035, A, (住友電気工業株式会社)13.9月.1994(13.09.94)特許請求の範囲&US, 5693115, A	1-8
Α	JP, 05-024854, A, (住友電気工業株式会社) 2. 2月. 1993 (02. 02. 93) 特許請求の範囲&US, 5330548, A	1-8

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

| | パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 06.12.99 国際調査報告の発送日 14.12.99 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4T 9728 日本国特許庁(ISA/JP) 深草 祐一 深草 祐一 第便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3463

